

Silicon Quad Schottky Diode

S450D

6V / 80mA

DATASHEET

OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1988

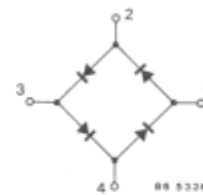
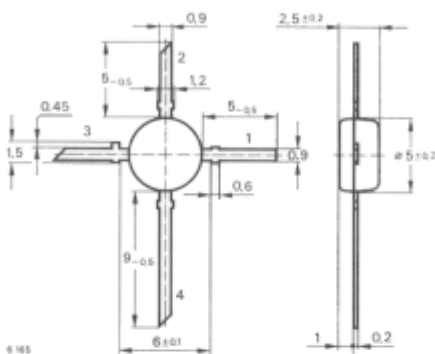
S 450 D**GaAs-Schottky Diodenquartett**

Vorläufige technische Daten für Muster

Anwendung: Ringmodulatoren

Besondere Merkmale:

- Geringe Durchlaßspannung
- Diagonal geringe Durchlaßspannungs-differenzen
- Geringer Durchlaßwiderstand
- Diagonal geringe Kapazitäten

Abmessungen in mm

Standard Kunststoffgehäuse
50 B4 DIN 41867
JEDEC TO 50
Gewicht max. 0,1 g

Absolute Grenzdaten

für Einzeldiode falls nicht anders angegeben

Sperrspannung	U_R	6	V
Spitzendurchlaßstrom	I_{FM}	80	mA
Gesamtverlustleistung $T_{amb} \leq 25^\circ\text{C}$	P_{tot}	100	mW
Sperrschichttemperatur	T_j	125	$^\circ\text{C}$
Umgebungstemperaturbereich	T_{amb}	-55...+125	$^\circ\text{C}$
Lagerungstemperaturbereich	T_{stg}	-55...+125	$^\circ\text{C}$

Kenngrößen

für Einzeldiode

	Min.	Typ.	Max.	
Durchlaßstrom			30	mA
Durchlaßspannung $I_F = 1\text{ mA}$	620			mV
$I_F = 10\text{ mA}$			820	mV
Differentieller Durchlaßwiderstand $I_F = 5\text{ mA}$			15	Ω
für Diodenring				
Diagonalkapazitäten $U_R = 0, f = 1\text{ MHz}$		700		fF
Diagonale Durchlaßspannungen $I_F = 1\text{ mA}$			40	mV
$I_F = 10\text{ mA}$			40	mV

S 450 D

